



求实 创新 合作

本站查询  Go

现在位置 : 首页 > 新闻动态 > 科研动态

新闻动态

## 第十三届中红外光电子材料与器件国际会议在京召开

| 16-11-07 | 访问次数 : | 【大 中 小】 | 【打印】 | 【关闭】

第十三届中红外光电子材料与器件国际会议于9月18日至22日在北京顺利召开。此次会议由中国科学院上海技术物理研究所和中国科学院红外成像材料与器件重点实验室主办，中科院上海技术物理研究所学术委员会主任何力研究员任大会主席。为期四天的会议里，来自中国、美国、英国、法国、德国、波兰、俄国等15个国家和地区的125名科学家、工程师、研究生等就中红外光电子材料与器件的最新科研进展以及未来发展方向进行了广泛的交流和探讨。

中红外光电子材料与器件国际系列会议已有20年的历史，第一届会议于1996年在英国Lancaster召开，之后每两年召开一次，主要在欧洲和北美举办。本届会议共收到91篇稿件，主题涵盖了新型红外与太赫兹光电材料、材料生长与表征、红外与太赫兹探测器、红外与太赫兹发光器、红外光电器件应用等多个方面。

会议主席何力研究员致开幕词，上海技物所党委书记龚海梅研究员代表主办单位致辞。匡定波院士、方家熊院士和美国科学院外籍院士李爱珍研究员等老一辈专家全程参加。会议安排5个大会报告，15个邀请报告，30个口头报告和41个张贴报告。德国慕尼黑工业大学Markus-C. Amann教授、美国Illinois大学Sivalingam Sivananthan教授、意大利Pisa大学Alessandro Tredicucci教授、美国Oklahoma大学Rui Q. Yang教授、中科院上海技术物理研究所胡伟达研究员等作大会报告；美国新墨西哥大学Sanjay Krishna教授、英国Lancaster大学Anthony Krier教授等15位知名专家作了邀请报告。II类超晶格红外探测材料与器件、新型二维材料、面发射中红外激光器、太赫兹材料与器件等话题引起了与会代表的强烈兴趣与热烈讨论。

国内，中科院上海技术物理研究所、中科院上海微系统研究所、中科院半导体研究所、华中科技大学等14家单位的职工与学生积极参会。作为会议主办单位，上海技物所共计43人参会，并作了5个口头报告和12个张贴报告，较全面地介绍了我所在碲镉汞红外焦平面材料与器件、II类超晶格材料与器件、InGaAs探测器、太赫兹激光器及相关基础研究方面的最新研究进展。会议期间，下一届会议主席宣布了第十四届中红外光电子材料与器件国际会议将于2018年9月在美国的亚利桑那州Flagstaff市召开；大会科学委员会讨论决定了第十五届会议将于2020年在英国召开。



网站链接

MORE

- 中国科学院红外成像材料与器件  
重点实验室
- 红外物理国家重点实验室
- 973计划-InGaAs项目
- 红外联合期刊编辑部
- 教育中心
- 所级公共设备区域中心
- 所IR知识仓储数据库
- 职工交互平台
- 图书馆网站
- 红外器件材料室

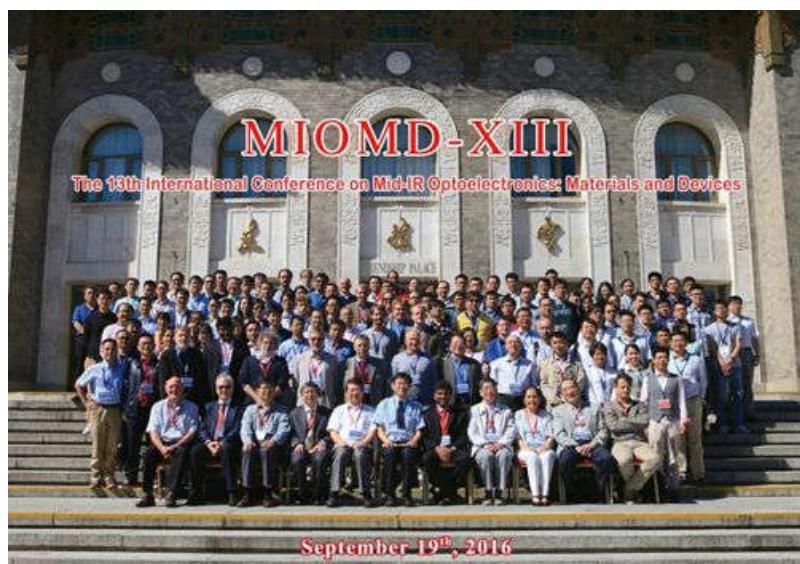
专题

MORE





开幕式现场



参会代表合照

» 评论



Copyright 2003 - 2013 All Rights Reserved 上海技术物理研究所 版权所有  
主办：中国科学院上海技术物理研究所 备案序号:沪ICP备05005482号

中国科学院上海技术物理研究所公益域名标识:

